Metal Contamination

Wafer 汙染評價

對應 200/300/450mm 的潔淨度評價

Wafer 表面的微量金屬分析

為了使半導體製造更有效率,大面積450mm Wafer正加速開發中。住化分析可評價對應至450mm 製程中之零件或製造裝置材料,其Wafer表面超微量金屬分析可達 E7atoms/cm²。

く分析流程 > 大面積蝕刻 加熱・濃縮處理 試料調整處理 定量分析(ICP-MS)

< 450mm Wafer表面的微量金屬分析定量下限說明 >

Н	4~9E7 atoms/cm² 1~5E8 atoms/cm²														Не		
Li	Ве		5~9E8 atoms/cm² 1~5E9 atoms/cm²								В	С	N	0	F	Ne	
Na	Mg		5~9E9 atoms/cm²									Al	Si	Р	S	CI	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Со	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Υ	Zr	Nb	Мо	Тс	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	ln	Sn	Sb	Те	Ι	Хе
Cs	Ва	L	Hf	Та	W	Re	Os	lr	Pt	Au	Hg	TI	Pb	Bi	Ро	At	Rn
Fr	Ra	Α															

L	La	Се	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Но	Er	Tm	Yb	Lu
Α	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Df	Es	Fm	Md	No	Lr

超微量化學汙染評價

從既有的經驗與知識,獨自設計的無化學汙染無塵室,可評價超微量表面分子的汙染物質。 (SMCs: Surface Molecular Contaminants)

く無金屬汙染實驗室>



<無有機汙染實驗室>



く 無離子汙染實驗室 >

